光半導体プロセス開発マネージャー/次世代の光半導体プロセス開発

募集職種

採用企業名
日本ルメンタム株式会社

求人ID
1617011

業種
電気・電子・半導体

会社の種類
中小企業 (従業員300名以下)

雇用形態
正社員

勤務地
神奈川県, 相模原市中央区

給与
1000万円 ~ 1400万円

勤務時間
9:00-17:30

休日・休暇
完全週休二日制

更新日
2026年11月18日 00:00

応募必要条件

職務経験
1年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

≪募集要項・本ポジションの魅力≫

- InP系光通信用半導体レーザ・フォトダイオードのウエハプロセス開発から量産技術の確立までを主導
- 年収1,000万 ~ 1,400万円の高待遇のもと、次世代の光半導体デバイス開発を牽引し、AI・HPC・6Gなど世界の通信インフラの進化に貢献できるやりがい
- R&D設計チームや製造・生産技術チームと連携し、プロセス技術の革新や歩留まり・生産性の改善を通じて、最先端技術の量産化を実現できる醍醐味
- 年間休日125日・完全週休2日制に加え、住宅手当やカフェテリアプラン、充実した退職金制度を備え、60歳以降も年収維持・昇給昇格が可能な環境

【業務内容】
＜ミッション＞
本ポジションは、光通信用半導体レーザ・フォトダイオードのウエハプロセスの開発を通して産業変革を支えるキーデバイスを創ることがミッションです。
次世代の製品を開発する上で、安定して量産できるかどうか、お客様の必要な製品へと仕上げられるかどうか、生産プロセスが肝心要な役割を担っています。
開発していただくのはInPウエハでの光半導体素子を作り上げるためのプロセス。スピード感のある開発サイクルの中で、ご知見とスキルセットを活かし、世界のデータ通信インフラを一緒に作っていただける方を募集しています。

＜具体的には＞

- ウェット/ドライエッチング、メタライゼーション、リソグラフィなどの NPI (New Product Introduction：新製品導入) のための個別プロセス研究の計画と実行をリード。
- 上記の職務を達成するために、R&D設計チーム および OPSウェハ製造・生産技術チームと連携し推進。
- 将来の量産に適用可能なプロセスフローを作成するために、プロセスステップをインテグレーション（統合）する。
- 生産性、歩留まり、コストの改善に貢献する新しいプロセス技術を提案する。

■当社について：
小さな光半導体デバイスで大きな社会貢献を。
AI・HPC・次世代通信を支える「電子I/Oの限界を超える光I/O」。
日本ルメンタムは、この構造転換の中核となる光半導体デバイスを自社開発・量産化する拠点です。

当社は、データセンタ / AIクラスタ / 次世代ワイヤレス通信（6G）に不可欠な光送受信トランシーバ向けのEML（Electro-absorption Modulator Integrated with DFB Laser）、CWLaser（Continuous Wave Laser）などを主力製品とし、CWDM / L-WDMなど多波長帯の高速光デバイスを展開。
電子伝送の限界に直面する産業構造の中で、光I/Oへの転換を先導するポジションを確立しています。

【雇用形態】
正社員

【給与】
年収：1000万円 〜 1400万円（年俸制）
管理監督者
※管理監督職は残業代は支給なし
※業績連動インセンティブあり（年1回）
※60歳定年後も職務内容変更なければ給与も変更なし。昇給昇格対象。一年更新。

【就業時間】
9:00-17:30（休憩45分）

【勤務地】
神奈川県相模原市中央区小山４－１－５５
■受動喫煙対策：屋内喫煙室あり

【休日休暇】

- 完全週休二日制
- 年間休日125日

【待遇・福利厚生】

- 各種保険完備
- 住宅手当
  ・対象： 単身30歳を迎える誕生月まで。または単身赴任者
  ・最大25,000円
- 既婚者住宅手当
  ・対象：借り主である物件。40歳を迎える誕生月まで。
  ・最大40,000円
- 単身赴任手当
  ・転居時一時金　80,000円
  ・別居手当　40,000円/月
  ・帰省手当　往復交通費実費1回分/月
- 定年【60歳以降の雇用条件】
  ・60歳以降も年収の変更なし
  ・昇給・昇格の対象
  ・契約期間：1年更新
- 確定拠出＆退職金
  ・本給月額(年俸の12等分)×6.5%を積み上げる
  ・うち27,500円をDC拠出し、残りは退職一時金へ
- 財形貯蓄
- カフェテリアプラン等有

スキル・資格

【必須要件】

- InP系光通信用半導体素子のプロセス開発経験
- 各種プロセス装置（露光装置、CVD、RIE等）や評価装置（SEM、AFM等）のオペレーションスキル
- 電子工学、電気工学、物理学、化学、またはそれらに関連する技術分野の学士号、修士号、または博士号
- 社内他部門との調整・交渉スキル
- NPI開発プロジェクトリードに加えて部下を率いたご経験
- 英語力（英語で会議をリードすることが出来る・読み書き）
- PCを使ったドキュメント(MS Word，Excel，PowerPoint)作成能力

【歓迎要件】

- 半導体デバイスの信頼性に関する知識
- 化合物半導体デバイス集積技術の開発経験
- FOWLP、CFETなど先進的プロセス技術に関する知識・経験

会社説明